Partial Translation of JP 64-27194, A

...omitted...

5 [Embodiment]

10

15

20

25

An embodiment of the present invention will now be explained with reference to the drawings.

Fig.1 is a cross-sectional view showing one embodiment of the thin film EL device of the present invention. Hereinafter, an example of the thin film EL device comprising a light emitting layer, principally composed of $Mg_{1-x}Ca_xS$ and doped with Eu will be described.

First, as shown in Fig.1, a transparent electrode 2 and a first insulator layer 3 composed of Ta_2O_5 with a thickness of 3000 Å are formed on a glass substrate 1, for example by vacuum evaporation method, sputtering or the like. Secondly, on the formed electrode 2 and insulator layer 3, a light emitting layer 4 composed of $Mg_{0.4}Ca_{0.6}S:Eu(0.5 \text{ mol}\$)$ is formed to have a thickness of 10000 Å by electron-beam vapor deposition. Furthermore, on the light emitting layer 4 and the other layers, a second insulator layer 5 composed of Al_2O_3 is formed to have a thickness of 3000 Å without breaking this vacuum condition. Finally, an upper layer Al electrode 6 is formed on this second insulator layer 5, to form the EL

device.

10

15

20

25

Fig. 2 is a characteristic diagram which compares the luminance, efficiency, and color purity of the thin film EL device according to the present invention and those of the conventional thin film EL device.

As shown in Fig. 2, the characteristics of the thin film EL device comprising the light emitting layer of Mg0.4Ca0.6S according to the present invention were compared with the characteristics of the comprising the light emitting layer of Mg_{0.4}Ca_{0.6}S:Eu(0.5 mol%) prepared in the same conditions as above device and the characteristics of the device comprising the light emitting layer of CaS:Eu(0.5 mol%). As a result, the device comprising the light emitting layer of CaS: Eu emitted deep red color having no problems with color while exhibiting inferior luminance purity, efficiency than the device according to this invention. The device comprising the light emitting layer of MgS:Eu exhibited the best luminance and efficiency, while emitting orange color having degraded color purity, and thus not usable as a red light emitting EL device.

Accordingly, the device comprising the light emitting layer of $Mg_{0.4}Ca_{0.6}S$ according to the present invention exhibit improved luminance and efficiency compared with the devices conventionally comprising the

light emitting layer of CaS and so forth, as well as providing a satisfactory color purity. The device can therefore provide superior characteristics than those of conventional devices on the whole.

5

...omitted...

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-027194

(43)Date of publication of application: 30.01.1989

(51)Int.CI.

H05B 33/14 C09K 11/00

CO9K 11/56

(21)Application number: 62-183920

(71)Applicant :

NEC CORP

(22)Date of filing:

22.07.1987

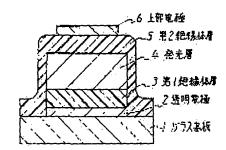
(72)Inventor:

YOSHIOKA TOSHIHIRO

(54) THIN FILM EL ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve luminance efficiency and element characteristic by forming a light emitting layer, consisting of sulfide of alkali–earth element activated with Eu, with mixed crystals of MgS and CaS. CONSTITUTION: An EL element is formed by forming a film of a transparent electrode 2 and a 1st insulation layer 3 on a glass substrate 1, forming over them a light emitting layer 4 with the composition of Mg1−xCaxS where the value of x is 0<x≤0.9, further forming over the light emitting layer 4 a 2nd insulating layer 5 and an Al electrode 6. With this constitution, both luminance and efficiency characteristic are improved while maintaining good color purity by using the mixed crystal of MgS and CaS as materials for the light emitting layer 4 consisting of alkali–earth sulfide activated with Eu.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-27194

⑤Int Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

匈公開 昭和64年(1989)1月30日

H 05 B 33/14 C 09 K 11/00 11/56 8112-3K F-7215-4H CPC 7215-4H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

ᡚ発明の名称 薄膜 E L 素子

②特 願 昭62-183920

❷出 願 昭62(1987)7月22日

の発明者 吉岡

俊 博

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

创出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

⑩代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 都 書

発明の名称

薄膜EL素子

特許請求の範囲

- (1) Euで付活されたアルカリ土類硫化物からなる発光層を有する薄膜EL案子において、前記発光層をMgSとCaSとの混晶で形成したことを特徴とする薄膜EL案子。
- (1) アルカリ土類硫化物からなる発光層母体 Mg₁-xCax Sの組成Xの値が0 < X ≤ 0 . 9 である特許請求の範囲第1項記載の薄膜E L素子。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は表示デバイスなどに用いる薄膜EL素子に関し、特にアルカリ土類硫化物を母体とし、 Euで付活された発光層を有する薄膜EL素子に

顔する.

〔従来の技術〕

従来、アルカリ土類確化物を母体とし且つEu (ユウロピウム)で付活された、死光層を有する 薄膜Eし素子は、色純度の高い赤色発光が得られ ることで注目されている。かかる薄膜Eし素子 は、従来第2図に示すように、発光層としてスパッタリング法や真空蒸着法で形成されたCaS: Eu薄膜が用いられている。

(発明が解決しようとする問題点)

上述したCaSを母体として、Euで付活された発光層を有する薄膜Eし素子は、ZnSを母体とする発光層を有する薄膜Eし素子では得られなかった高い色純度の赤石発光を示すことで注目されている。しかしながら、輝度および効率等の素子特性は依然として不充分であるという問題がある

本発明の目的は、色純度の高い赤色発光を示す Euで付活されたアルカリ土類硫化物からなる発 光層を用いて素子の輝度及び効率を向上させるこ とのできる寝腹EL素子を提供することにある。 (問題点を解決するための手段)

本発明の薄膜EL素子は、Euで付活された アルカリ土類硫化物からなる発光層をMgSと CaSとの混晶で形成したものである。

(作用)

(実施例)

次に、本発明の実施例を図面を参照して説明す

Cao.s Sを発光層とする薄膜EL素子の特性 と、この素子と同様な条件で作成したMgS: Eu (0.5mmo1%)を発光層とする素子及 びCaS: Eu (0.5mo1%)を発光層とす る素子の特性とを比較した結果、CaS:Euを 発光層とする素子は深い赤色を呈し、色純度では 問題がないが、輝度・効率とも本発明による素子 よりも劣っている。また、MgS:Euを発光層 とする素子は輝度、効率が最も優れているが、色 純度が悪くしかも発光は橙色であり赤色発光EL 素子として利用できないという欠点がある。この ように、本発明によるMgn.4 Cao.6 Sを発光 層とする素子は輝度、効率とも従来のCaS等を 発光層とする素子より改善されており色純皮も良 好であるので、総合的にみて従来素子より特性の 秀れたものが得られる。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明の薄膜EL素子は Euで付活されたアルカリ土類硫化物からなる発 光層材料としてMg:-x Cax S: Euを用いる ъ.

第1図は本発明の一実施例を示す薄膜EL素子の断面図である。以下、Mg_{1-x} Cax Sを母体にしてEuで付活された発光層を有する薄膜EL素子を例にとり説明する。

第1図に示すように、まず、真空蒸着法または スパッタ法等によりガラス基板1上に透明をを 及び3000人のTa20°からな第一絶極を 及び3000人のTa20°から成膜された電極を および絶縁体質3の上にMg。4 Сa。6 S: Eu(0.5m。1%)からなる発光度する。8 Eu(0.5m。1%)からなる発光度する。8 Eu(0.煮着法で10000人形成する。9 に、この真空状態を破らずにこれら発光の上に 上からAℓ20°の第二絶縁体層5を300日に 上からAℓ20°の第二絶縁体層5の上に 形成する。最後に、この第二絶縁体層5の上に 部Aℓ電極6を形成してEL素子を形成する。

第2図は本発明による薄膜EL第子と従来の薄膜EL素子との輝度、効率および色純度を比較した特性図である。

第2図に示すように、本発明によるMga.4

ことにより、CaS:Euのもつ色純度の良好性を保ったまま素子等の輝度及び効率特性を向上させることができるという効果がある。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す薄膜EL素子の断面図、第2図は本発明の薄膜EL素子と従来の薄膜EL素子との輝度、効率及び色純度を比較した特性図である。

1 ··· ガラス基板、2 ··· 透明電極、3 ··· 第一絶緑体層、4 ··· M g 1-x C a x S : E u 発光層、5 ··· 第二絶緑体層、6 ··· 上部電極。

代理人 弁理士 内 原



